

太陽電池の新評価技術 (屋外高精度測定技術、非接触電位測定技術)

太陽光発電研究センター 評価・標準チーム

菱川善博·山越憲吾·大島博典·武内貴和·松田洋治· 深堀明博·小沼 剛*

*現所属:株式会社 東光高岳

背景、目的

AIST

- 太陽電池実用化の進展に伴い、屋外で設置され稼動する状態で
 太陽電池の性能を高精度、非接触に評価するニーズが高まる。
- ・屋外性能評価の条件等は現行のJISやIEC規格にも規定されているが、測定精度に及ぼす影響は十分検証されていない
- ・測定精度、屋外でそれらの条件が満たされる測定機会が不十分





25°C, AM1.5 **Arelick** Irradiance temperature spectrum

パワー定格

100 mW/cm²

 ・ 産総研が開発してきた屋内高精度性能 評価技術を活かして、屋外測定における 精度と測定機会を大幅に改善するための要素技術を検討した



屋外高精度IV特性測定技術*

日射変動 <u>温度測定・制御</u> スペクトル測定・補正









*Y. Hishikawa et al., "Accurate outdoor measurement technology of PV devices", Proceedings of JSES/JWEA Joint Conference (2014) 305-308.



AIST 太陽光発電研究 成果報告会 2015







2014/7/31

1.2



- 屋外高精度測定技術:ガイドライン概要
- ・短時間測定< 200 ms
 →変動抑制≦0.5%、機会増加≧280日(0.9 suns)
- (PV reference cell or monitor)
- 温度センサ(RTD等)の樹脂テープ(PI等)による貼付。
 屋内高精度測定とほぼ一致することを確認した





- ・短時間測定<200 ms
 →変動抑制≦0.5%、機会増加≧280日(0.9 suns)%
- (PV reference cell or monitor)

PAIST

- 温度センサ(RTD等)の樹脂テープ(PI等)による貼付(輻射率) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 測定精度2%より良(屋内高精度測定との比較)
 の基本精度を確認した。
- 更に1%以内の測定再現性の可能性を検証*



*A. Fukabori et al., "Study of highly accurate outdoor characterization technique for PV modules", Proceedings of The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-6), (2014), Kyoto.



·200ms



非接触電位測定技術

- 太陽電池モジュールおよびモジュール中の要素セルの電位は、セル、モジュールやアレイの性能と均一性、動作状態等を反映する重要な指標
- ・影や性能のばらつきによるhot spot等、信頼性評価の観 点からも重要
- ・従来は非接触での測定はできなかった



太陽電池モジュールおよび要素セルの非接触電位測定技術 を初めて検討し、屋内測定および系統連系中の屋外測定に より、各種太陽電池で実証した





・各種太陽電池モジュール(結晶Si,薄膜)

- •屋内、屋外、系統連系
- •測定方法、条件、解析



非接触型表面電位計 春日電機製 KSDシリーズ表面電位測定器カスタム品



結晶**Si**太陽電池モジュールおよび各要素 セルの被接触電位測定(ガラス面より)

30

25 24

12 13 14 15 16 17

31

45 44 43 42 41

28 29

27 26

10

Cell No.

52 53

21 20

38

54

40 39

33 34

32

23 22



精度検討(屋内測定)

Cell No.

- 非接触で太陽電池モジュール(セル)の電位を 計測できることが明らかになった。
- ・1セル(~0.5 V)より良い測定精度/再現性を 確認。サンプル、計測方法に大きく依存。







系統連系動作中のPVシステム中の結晶Si、
 薄膜SiおよびCIGS太陽電池モジュール電
 位を非接触で測定できることを確認。



高電圧の薄膜太陽電池では結晶Siより良い
 S/N比が得られやすい傾向。





<u>c-Siモジュール屋外測定</u>

1	10	11	20	21	30	31	40
			i	- j			

結晶Siモジュール 2013.7.12 10:00~11:00頃



モジュール設置位置



モジュール表面より測定 GNDはモジュール架台へ(但し塗装面) GND電位:22.2V→(1回目測定)→(2回目測定)→22V



薄膜モジュール屋外測定

1	
2	
3	
:	
161	

薄膜モジュール 2013.7.12 10:00~11:00頃



モジュール設置位置





PAIST

2

Module No.

3







0

PAIST

屋外測定(3)

・表面(ガラス面)からの測定:プローブによる影が測定精度
 に影響を及ぼす恐れ⇒裏面からの測定が望ましい。





系統連系中の各種結晶Si太陽電池モジュールにおける非接触電位測定(測定面の影響)



結論

(屋外高精度測定技術)

- ・IV特性測定時間 ≦200 ms の高速測定により、日射変動が顕著な日においても 変動率を≦0.5%に抑制でき、高精度な屋外IV特性測定が可能である。
- ・日射スペクトル変動による誤差を検討した。結晶Siの場合はその誤差は測定結果
 に大きな影響を与えない。
- ・測定精度2%より良(屋内高精度測定との比較)の基本精度を確認した。更に高精度な測定再現性(≦1%)を達成できる可能性が有る。

(非接触電位測定技術)

- ・静電誘導を利用した非接触静電位測定技術によって各種太陽電池モジュールおよ びセルの電位を測定することが可能である。
- ・システムの稼働状態に影響を与えずに、ポータブルな計測器でモジュールおよびセルの動作電圧を測定可能である。
- ・稼働中のモジュールの出力電圧等を測定、検出する用途に適している。1セル程度の分解能を確認した。
- ・被測定モジュールの状態や測定環境、測定方法が測定精度に大きな影響を与える 可能性があるが、その詳細はまだ定量化されていない。今後応用を進めると共に、 これらの要素を検証して影響を明確化、定量化することが重要である。